

آماده سازی هدفهای مناسب برای اندازه گیری سطح مقطع های واکنش های PIGE

جو کار، علیرضا^{*}؛ کاکویی، امید رضا؛ لامعی رشتی، محمد

سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشکده فیزیک و شتابگرها، صندوق پستی ۸۳۶-۱۴۳۹۵، تهران - ایران

چکیده:

توابع تحریکی بیشتر واکنش های گسیل پرتو گاما پروتون - القایی (Proton Induced Gamma-ray Emission) حاصل از بمباران هدفهای سبک با باریکه پروتون کم انرژی، دارای رزونانس های باریک و متوالی هستند که برای اندازه گیری آنها نیاز به استفاده از هدفهای سبک با باریکه پروتون کم انرژی، دارای رزونانس های باریک و متوالی هستند که برای اندازه گیری آنها نیاز به استفاده از هدفهای سبک با باریکه پروتون کم انرژی، دارای رزونانس های باریک و متوالی هستند که برای اندازه گیری آنها نیاز به استفاده از $^{27}\text{Al}(\text{p},\text{p}\gamma_{1,2})^{27}\text{Al}$ ، $^{27}\text{Al}(\text{p},\text{p}\gamma_1)^{28}\text{Si}$ و $^{31}\text{P}(\text{p},\text{p}\gamma_1)^{28}\text{Si}$ با روش لا یه نشانی فیزیکی بخار تهیه شدند. کلمات کلیدی: هدفهای نازک Al ، Si و P ، واکنش های گسیل پرتو گاما پروتون - القایی (PIGE)، مقطع های دیفرانسیلی.

مقدمه:

در آزمایشگاه های فیزیک هسته ای، واکنش های هسته ای از بمباران هدفهای مناسب ایجاد می شوند. مشخصات هدف انتخابی به ماهیت آزمایش، واکنش هسته ای تحت مطالعه، ساختار هسته هدف و مشاهدات حاصل از آن بستگی دارد. هدفهای نازک یا به صورت خود نگهدار و یا بر روی یک زیر لایه مناسب نشانده می شوند. طیف وسیعی از هدفهای مورد استفاده در مطالعات واکنش های هسته ای به روش لا یه نشانی فیزیکی بخار بر روی زیر لایه های نازک یا ضخیم رسوب داده می شوند. زیر لایه ها از عناصری انتخاب می گردند که مواد هدف به صورت یکنواخت و با چسبندگی خوب بر سطح آنها بنشینند. آنها باید در هنگام بمباران با باریکه، تولید زمینه مزاحم نکنند و ضریب انتقال حرارتی مناسب داشته باشند تا از آسیب هدف در اثر حرارت تولید شده جلوگیری شود. برای زیر لایه های ضخیم بهترین انتخاب، تانتالم، مولیبدن، مس و نیکل هستند. این عناصر به علت عدد اتمی نسبتاً بالایی که دارند در انرژی های پایین تمایل به واکنش هسته ای ندارند. همچنین نقطه ذوب آنها بالا بوده و در مقابل جریان زیاد مقاوم هستند. در تعدادی از آزمایش ها مانند اندازه گیری سطح مقطع، استفاده از زیر لایه های نازک مناسب است. این زیر لایه ها به قدری نازک انتخاب می شوند که گرمای ذخیره شده در آنها در مدت بمباران با باریکه (در بعضی از آزمایشها زمان بمباران هدف تا چندین روز متوالی به طول می کشد) ناچیز می باشد. برای زیر لایه های نازک بهترین انتخاب کربن، طلا و نقره هستند [۱]. بعد از تهیه زیر لایه مناسب، مواد هدف بر روی آنها نشانده می شوند. استفاده از هدف نازک و بادوام برای اندازه گیری دقیق سطح

قطعه ها بسیار مهم و تعیین کننده می باشد. شرایط اصلی یک هدف مناسب به شرح زیر است:

۱. هدف باید همگن و به اندازه کافی نازک باشد، به طوری که افت انرژی ذرات در آن کمتر از پهنهای رزونانس شود. با رعایت این شرط می توان رزونانسهای متواالی و نزدیک به یکدیگر را بدون همپوشانی تمیز داد. مهمتر اینکه اگر ضخامت هدف نازک نباشد، بهره پرتو گاما اندازه گیری شده معادل با انتگرال سطح مقطع بر روی افت انرژی خواهد بود تا معادل با مقدار سطح مقطع واکنش هسته ای مورد مطالعه.
۲. نمونه های ساخته شده باید پایداری مکانیکی، شیمیایی و حرارتی مناسب داشته باشد، بطوریکه در حین پرتو دهی مخصوصاً در جریان های زیاد و زمانهای طولانی تجزیه و تخریب نشوند.
۳. هدایت الکتریکی و گرمایی مناسب داشته باشد.

در سالهای اخیر، روش آنالیز PIGE به علت پتانسیل بالایی که در آنالیز کمی و همچنین نمایه عمقی عناصر سبک (Z<18) دارد به عنوان یک روش مکمل برای PIXE مورد توجه قرار گرفته است. به دلیل وجود رزونانس های تیز در بسیاری از سطح مقطع های این برهمکنش ها، آنالیز به روش PIGE، تکنیک بسیار مناسبی برای تعیین نمایه عمقی رزونانسی با قدرت تفکیک بالا نیز می باشد. در حال حاضر محدودیت عمدۀ آنالیز به روش PIGE متنکی بودن آن به مقایسه با نمونه استاندارد است. برای دستیابی به نتایج بهتر و مستقل از استاندار، داشتن مقادیر دقیق و قابل اعتماد داده های سطح مقطع الزامی می باشد. برای این منظور آژانس بین المللی انرژی اتمی پروژه جدیدی در ارتباط با داده های پایه برای آنالیز به روش PIGE را در سال ۲۰۱۱ تصویب و آغاز نموده است [۲]. این پروژه با شرکت چند آزمایشگاه معتبر که در زمینه آنالیز های باریکه یونی فعال می باشند شروع شده است. آزمایشگاه واندوگراف پژوهشگاه علوم و فنون RBS، Micro-PIXE، PIXE و NRA را دارد به عنوان یکی از آزمایشگاه ها در این پروژه بین المللی مشارکت داشته است.

روش کار :

در این کار تحقیقاتی، تمام هدفها نازک به روش تبخیر فیزیکی در خلاء بر روی زیر لایه های نازک نقره و کربن نشانده شدند. دستگاه های لایه نشانی به روش تبخیر فیزیکی در خلاء، از یک منبع حرارتی و یک زیر لایه که درون یک محفظه خلاء محبوس شده اند، تشکیل شده است. محفظه تا فشاری کمتر از 10^{-5} میلی بار تخلیه می شود. منبع حرارتی معمولاً یک بوته یا فیلمان گرم شده توسط روش مقاومتی می باشد. اتم های بخار شده حاصل از حرارت ترکیب داخل بوته در مسیر مستقیم به سمت زیر لایه حرکت کرده و بر روی آن انباست می شوند. در این روش باید به این نکته توجه کرد که در صورت استفاده از هر نوع ترکیب شیمیایی، ممکن است بعد از انجام لایه نشانی همان ترکیب با همان نسبت

استوکیومتری اولیه نباشد. بنابراین باید بعد از لایه نشانی، استوکیومتری لایه تشکیل شده بررسی شود. شکل (۱) نمایی از دستگاه لایه نشانی مورد استفاده را نشان می‌دهد. زیرلایه‌های نقره مورد استفاده نیز با همین روش بر روی سطح شیشه (لام میکروسکوپ) نشانده شده‌اند. شیشه‌های لام قبل از استفاده با مواد شوینده و یا محلول آب قند آغشته شده و بعد از آن خوب خشک می‌شوند. بعد از آنکه نقره بر روی شیشه لام تبخیر شد، همانطور که از شکل (۲) مشاهده می‌شود، با وارد کردن لام در ظرف آب مقطر گرم (دماي C^{90}) در زاویه 45° در اثر نیروی کشش سطحی آب و حل شدن شوینده یا محلول آب قند موجود بر سطح لام، فیلم نازک نقره از لام به آرامی جدا شده و بر سطح آب شناور می‌شود [۳]. در این مرحله، فیلم‌های جدا شده را بر روی فریم‌هایی از جنس الومینیوم قرار داده و برای بمباران بر سیستم نگهدارنده هدف در داخل محفظه واکنش نصب می‌شوند. در بعضی مواقع به علت اینکه مایع شوینده یا آب قند به طور یکنواخت بر سطح لام شیشه‌ای توزیع نمی‌شوند، فیلم نقره در هنگام جداسازی از روی شیشه پاره می‌شود و یا بر سطح فیلم سوراخ‌های ریز ایجاد می‌شود. برای رفع این مشکل از تبخیر حدود 30 mg $BaCl_2$ بر روی لام شیشه (در فاصله 12 cm از بوته) به جای مواد شوینده یا آب قند استفاده شد [۴]. در مورد جدا سازی فیلم کربن از لام، چون احتمال پاره شدن آن زیاد است، فیلم کربن روی لام شیشه‌ای را در ماده‌ای آلی بنام زاپون لاکور (مخلوطی از 30 درصد کولودین و $70\text{ درصد آن-آمیل استات}$) غوطه ور شد. پس از 24 ساعت نگهداری در دسیکاتور و خشک شدن کامل، آنرا وارد آب مقطر کرده و فیلم کربن را از سطح لام جدا نمودیم. لازم به ذکر است مقداری از ماده زاپون لاکور بر روی سطح فیلم کربن باقی می‌ماند که در حین بمباران با باریکه قسمتی زیادی از آن تبخیر شده و مشکلی برای آزمایش ایجاد نمی‌کند. برای اندازه‌گیری توابع تحریکی واکنش‌های $^{29}Si(p,p\gamma_1)$ و $^{28}Si(p,p\gamma_1)$ $110\text{ پودر منواکسید سیلیسیم}$ را بوسیله حرارت دادن بوته‌ای از جنس تانتالم، بر روی زیر لایه نقره که در فاصله 35 cm از بوته قرار دارد، تبخیر شد. قبل از استفاده، رطوبت پودر منواکسید سیلیسیم را با گذاشتن آن در آون در دمای حدود 120°C درجه برای 30 دقیقه گرفته شده و تا شروع لایه نشانی در دسیکاتور نگهداری شده است. باید توجه داشت که منواکسید سیلیسیم قبل این که به نقطه ذوب تصعید می‌شود. همچنین چون در مرحله لایه نشانی، ذرات ریز پودر بر اثر گرمای کسب شده به اطراف پخش می‌شوند، حفره‌های سوزنی شکلی بر سطح هدف تشکیل می‌شود که باعث آسیب دیدن آن در حین تشکیل لایه نازک می‌شوند. به طور کلی مشاهده می‌شود که احتمال ایجاد حفره‌های سوزنی در دمای بالای 135°C درجه سانتیگراد زیاد می‌شود [۵]. برای جلوگیری از این پدیده، فاصله بوته از زیر لایه نقره را افزایش داده و آهنگ افزایش جریان (دمای بوته) را کند شد. بطوری که لایه نشانی در سه مرحله انجام گردید. با وجود اینکه کم کردن آهنگ افزایش جریان باعث کاهش سوراخ‌های سوزنی شکل بر سطح فیلم شد، ولی به علت افزایش زمان تبخیر باعث

ایجاد چروک بیشتری بر سطح هدف گردید. بعد از خارج کردن هدف از دستگاه لایه نشانی، آن را برای مدت ۴-۳ دقیقه در دمای حدود ۴۰ درجه سانتیگراد در محیط هوا مقابل لامپ فلورسنت قرار گرفت. این عمل باعث افزایش دوام فیلم مونوکسید می شود [۶]. با این حال فیلم متواکسید سیلیسیم تشکیل شده به طور یکنواخت و با چسبندگی و دوام بسیار خوبی بر سطح زیرلایه نقره نشست. بطوریکه در مدت ۴۸ ساعت بمباران متوالی با باریکه پروتون $nA = 100-700$ هیچ گونه آسیبی در هدف مشاهده نشد. برای اندازه گیری سطح مقطع های واکنش $^{31}P(p,p\gamma_1)^{31}P$ ، 270 mgr پودر فسفید روی را با عبور جریان از بوته مولیبدن، بر روی یک زیر لایه کربن نازک که در فاصله $12/5\text{ cm}$ از بوته قرار گرفته، نشانده شد. آنالیز PIGE پودر فسفید روی خریداری شده وجود ناخالصی آلومینیم را نشان داد. با توجه به اینکه در طیف RBS، قله های مربوط به آلومینیم و فسفر با هم تداخل می کنند، از این رو برای ممانعت از نشستن ذرات آلومینیم در فرایند لایه نشانی از اختلاف دمای تبخیر بین آلومینیم و فسفید روی استفاده شد. لایه نشانی با آلومینیم با بوته مشابه و همچنین ولتاژ یکسان نشان می دهد که آلومینیم در جریان $A = 150$ شروع به ذوب شدن می کند. از این رو جریان را به آرامی تا $A = 140$ افزایش داده و بالافاصله کاهش می دهیم. این فرایند سه مرتبه تکرار شده است. نهایتاً فیلم یکنواختی از فسفید روی بر سطح زیر لایه کربن تشکیل شد. فیلم تهیه شده در مقابل باریکه پروتون با جریان حدود 50 nA ، برای چندین ساعت بطور مداوم پرتو دهی شد. برای اطمینان از پایداری هدف در حین آزمایش، استوکیومتری هدف چندین بار بوسیله طیف RBS ناشی از ذرات آلفا با انرژی $MeV = 2/5$ بررسی شد، نتایج هیچگونه نشانه ای از آسیب رسیدن به نمونه را نشان ندادند. در هنگام استفاده از فسفید روی (مرگ موش) باید سمیت شیمیایی آن را به خاطر داشت. در آخر برای تهیه هدف نازک آلومینیم، 50 mgr مفتول آلومینیم خالص به وسیله بوته سیمی شکلی از جنس تنگستن، بر روی زیر لایه نازک نقره که در فاصله $12/5\text{ cm}$ از بوته نصب شده است، نشانده شد.

نتایج و بحث:

برای آماده سازی فیلم های نازک مناسب هر یک هدفهای Al ، Si ، P ، لایه نشانی آنها چندین بار انجام شد تا نهایتاً هدفهای نازک، همگن و بادوام تهیه شدند. مشخصات هدفهای مورد استفاده برای اندازه گیری سطح مقطع واکنش های PIGE در جدول (۱) خلاصه شده است. ضخامت هدف های Al/Ag ، SiO/Ag و Zn_3P_2/C با استفاده از طیف های RBS حاصل از ذرات آلفا با انرژی های $2/5\text{ MeV}$ و مقایسه طیف های بدست آمده با نرم افزار SIMNRA بدست آمده است [۷]. در شکل (۳ تا ۵)، این نوع طیفها نمایش داده شده اند. افت انرژی پروتون های در فیلم های هدف با استفاده از نرم افزار SRIM-2006 محاسبه شده است [۸]. افت انرژی پرتو نهایی داخل هدفهای تهیه شده در محدوده پهنای بیشتر رزونانس های واکنش های PIGE مورد مطالعه می باشد. شکل (۶) تابع تحریکی اندازه گیری شده برای

واکنش $^{29}\text{Si}(\text{p},\text{p}\gamma_1)^{29}\text{Si}$ را نشان می دهد [۹]. همانطور که از این شکل مشاهده می شود رزونانسها باریک و متواالی بخوبی مشخص می باشند. این شرایط برای دیگر اندازه گیری ما در مورد هدفهای Al و P نیز دیده می شود [۱۰ و ۱۱]. هدف این کار تحقیقاتی تهیه هدفهای نازک، بادوام و همگن Si-Al و P برای اندازه گیری سطح مقطع واکنشها است. به این منظور هدفهای نازک Al/Ag، SiO/Ag و Zn₃P₂/C به ترتیب با ضخامتها ۲۹، ۲۶ و ۱۱۰ $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ تهیه شدند. در توابع تحریکی اندازه گیری شده با این هدفها، رزونانسها باریک و نزدیک بهم بخوبی استخراج شدند.

مراجع :

- [۱] C. Iliadis, Nuclear Physics of Stars, Cauldrons in the Cosmos, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, ISBN 978-3-527-40602-9 , p.249.
- [۲] D. Abriola, P. Dimitriou, A. Pedro de Jesus, Summary Report 1st Research Coordination Meeting Development of Reference Database for Particle-Induced Gamma ray Emission (PIGE) Spectroscopy, IAEA Headquarters, Vienna, Austria. 2011.C.
- [۳] A. Stolarz, J Radioanal Nucl Chem 299 (2014) 913.
- [۴] S.H. Maxman, Nucl. Instr. Meth. 50 (1967) 53.
- [۵] Y. Lachance, J. C. Roy, Rev. Sci. Instrum. 43 (1972) 1382 .
- [۶] G. Hass, J. Am. Ceram. Soc. 33 (1950) 353.
- [۷] M. Mayer, SIMNRA, Report IPP 9/113, Max Planck institute fürplasmaphysik, Germany, 1997.
- [۸] J.F. Ziegler, M.D. Ziegler, J.P. Biersack, Nucl. Instr. Meth. B 268 (2010) 1818.
- [۹] A. Jokar, O. Kakuee, M. Lamehi-Rachti, Nucl. Instr. Meth. B 371 (2016) 37.
- [۱۰] A. Jokar, O. Kakuee, M. Lamehi-Rachti, Nucl. Instr. Meth. B 362 (2015) 138.
- [۱۱] A. Jokar, O. Kakuee, M. Lamehi-Rachti, Nucl. Instr. Meth. B 383 (2016) 152.

جدول (۱) مشخصات هدفهای مورد استفاده برای مطالعه مقطع های واکنش های PIGE

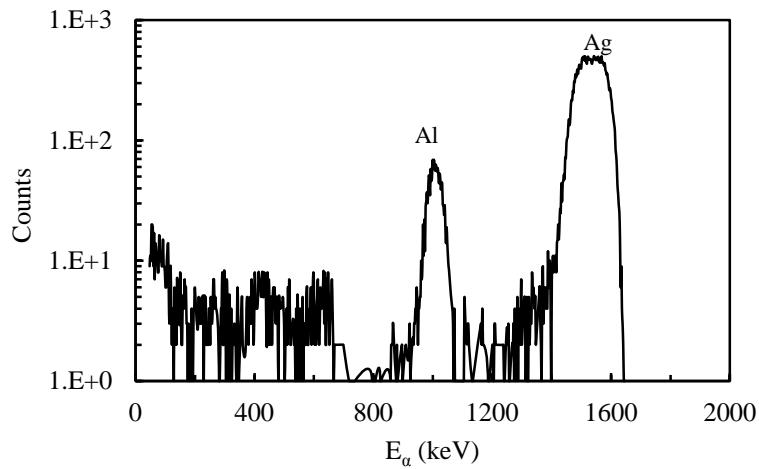
هدف	ضخامت زیر لایه ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)	ضخامت هدف ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)	افت انرژی در بازه $E_p = 2-3 \text{ MeV}$ (keV)
Al/Ag	۱۲۹	۲۹	۲/۹-۲/۲
SiO/Ag	۹۷	۲۶	۴/۳-۳/۲
Zn ₃ P ₂ /C	۱۰۰	۱۱۰	۷/۴-۵/۷



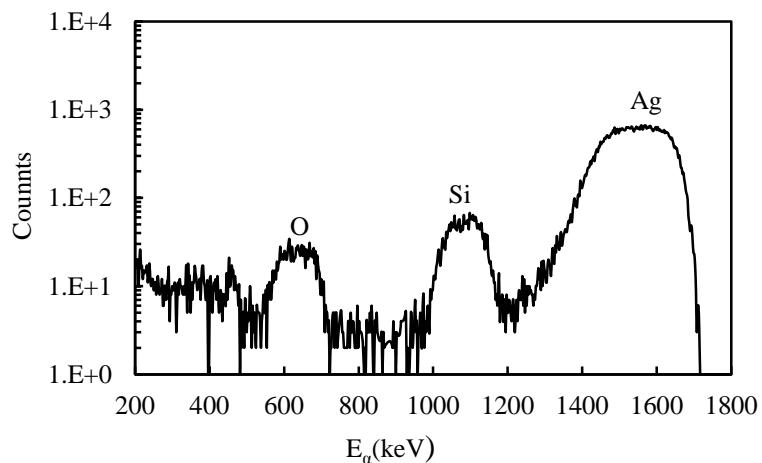
شکل (۱) دستگاه لایه نشانی آزمایشگاه واندوگراف.



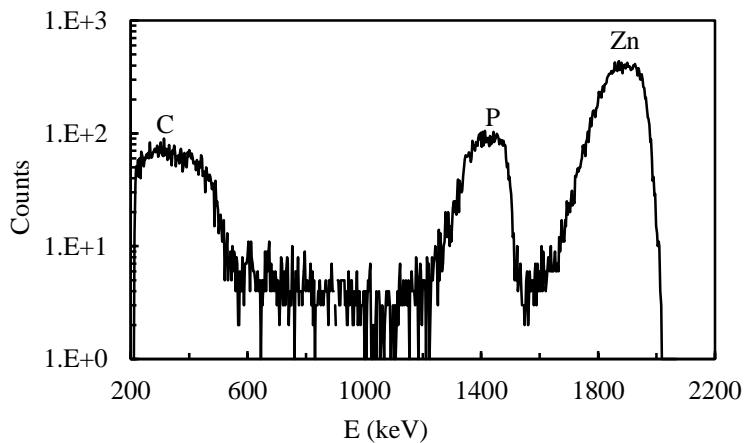
شکل (۲) جداسازی فیلم از لام شیشه‌ای.



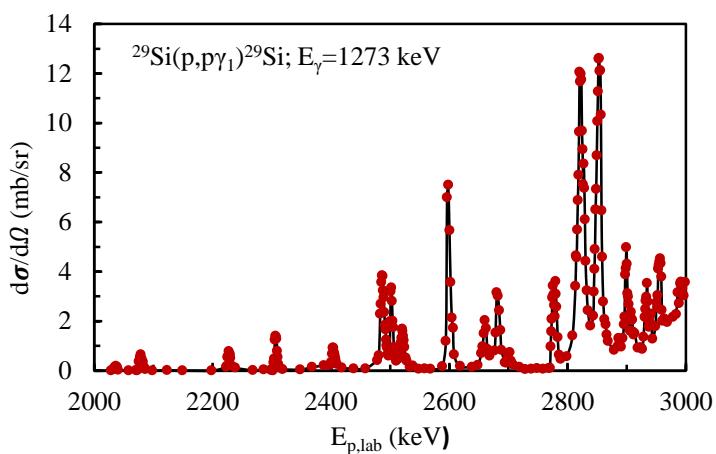
شکل (۳) طیف پس پراکندگی ذرات آلفا حاصل از بمباران هدف Al/Ag با باریکه هلیم ۲ MeV و زاویه پراگندگی 165° برای اندازه‌گیری ضخامت هدف.



شکل (۴) طیف پس پراکندگی ذرات آلفا حاصل از بمباران نمونه SiO/Ag با باریکه هلیم ۲ MeV.



شکل (۵) طیف پس پراکندگی ذرات آلفا حاصل از بمباران هدف Zn_3P_2/C با باریکه هلیم $2/5$ MeV.



شکل (۶) تابع تحریکی اندازه گیری شده برای گامای 1273 keV در زاویه آشکارسازی 90° .